BL13XU 表面・界面構造解析

1. 概要

表面や界面では、物質のもつ対称性が破れるため結晶 のかたまり(バルク)とは異なる特徴的な原子配列をと り、それに起因して多様な物性があらわれる。表面・界 面構造解析ビームラインBL13XUでは、X線の回折・散 乱現象を利用して金属、半導体結晶の表面構造のその場 観察のほか、酸化物結晶、有機結晶、触媒の表面層や、 その上に成長した薄膜・ナノ物質構造が調べられている。 デバイス材料の局所歪みの評価や、静的な構造解析にと どまらない外場印加時の表面や界面の動的構造変化のそ の場観察、表面における位相問題への取り組みなど、多 岐にわたるX線回折・散乱実験が行われている。

第1実験ハッチでは、高精度X線回折装置を用いた薄 膜、固体液体界面、ナノ物質の解析実験、第3実験ハッ チでは、超高真空表面X線回折装置による固体表面のそ の場観察実験、第4実験ハッチでは、高分解能ナノビー ム回折装置によるデバイス材等の局所構造解析実験が主 に行われている。第2実験ハッチは、ユーザー持ち込み 装置用の実験ハッチである。標準アンジュレータ・光学 系に加え、非対称分光結晶を用いた大強度光学系も利用 できる。利用ビーム位置を安定化させるシステムのほ か、放射光の波長選択性を活用した異常分散X線回折等 のエネルギー可変型実験を効率化する光学系も整備され ている。以下に2017年度に行われた技術開発・高性能 化の詳細について報告する。

2. 実用材料のプロセス処理中その場回折実験の実現

近年、記憶媒体に用いられる磁気ヘッド材料である磁 性薄膜など実用材料の解析を望むユーザーが増加してい る。その要望のなかでも、特に、実用材料作製における プロセス処理中の構造変化を観察したいという声は大き い。そこで、材料加熱処理中の様子をリアルタイムで放 射光観察するための計測基盤を整備した。

図1にその場観察回折実験のレイアウトを示す。第1 実験ハッチに設置されている多軸回折装置に、真空度 10⁻⁵Paから10⁻⁶Pa台の真空中で試料を600℃までその 場加熱可能な真空加熱装置を組み込んでいる。真空容器 上部に放射光観察のためのドーム型X線窓が取り付け られている。図1右下挿入図に示すとおり、ドーム型X 線窓の中に10 mm角程度の大きさの試料が収められる ようになっている。試料台内部に加熱ヒーターが組み込



図1 その場観察回折実験のレイアウト。右下挿入図はドーム 型X線窓内部の試料まわりの様子

まれており、試料台中央には試料温度をモニターするた めの熱電対が取り付けられている。そのため、フィード バック制御機能をもつ温度調整器を使用して自由に試料 温度を設定できる。試料加熱中の熱輻射による真空容器 やX線窓の昇温を極力低減させるために、試料台を囲む ようにリフレクタ(反射板)が2枚装備されている。さ らに、本装置には水冷ジャケットと水冷ステージが取り 付けられており、本装置を直接取り付けるゴニオステー ジは全く昇温しないつくりとなっている。

加熱処理条件を変えた複数のオフライン作製試料を SPring-8に持ち込んで評価する従来の方法では、試料作 製・処理条件のばらつきといった外的要因によって生じ る試料毎の回折強度のばらつきの影響が避けられない。 一方、本方法では同一試料の同一箇所の温度による構造 変化を評価することが可能であり、ユーザーは上述の外 的要因を解除したより高精度なデータを持ち帰ることが できる。例えば、コバルト系磁性薄膜を評価したユー ザー実験では、加熱時間によって結晶粒径が系統的に変 化する様子をとらえることができた。このように本計測 基盤の整備によって、より質の高いユーザー支援が可能 となった。

3. 高分解能マイクロX線回折装置

本装置は、半導体・デバイス材料の格子歪と格子面の 傾きを分離して高分解能に分析することができ、利用X 線のエネルギーに応じて集光素子であるフレネルゾー ンプレート(FZP)又は屈折レンズ(CRLs)を選択し て使用している。しかし、集光素子の切替には時間がか



図2 集光光学系切替機構の概要 (a) 概要図、(b) 装置の外観

かるため、1件のユーザー課題で2つの集光素子を利用 することは難しかった。そこで、2017年度にはこの2つ の集光光学系を容易に切替可能とする調整機構の導入を 行った。

図2に集光光学系切替機構の概要を示す。2つの集光 素子で共通して使用するスリット、アッテネーター、強 度モニターが上流側に設置されており、その下流に切替 機構が設置されている。本機構は二階建ての構造になっ ており、下段にFZPユニット、上段にCRLsユニットが 設置されている。FZPの上流側にはセンターストップ が設置されている。一方、CRLsとしてX線エネルギー 20、25、30 keV用の石英製キノフォームレンズが利用 でき、2つの一次元集光用レンズを縦横に組み合わせて 二次元集光が実現される。手動ステージでこれらを上下 することにより、集光素子を切り替えることができる。 ステージにはマイクロゲージが取り付けられ、切替時の ステージ位置を1 μm以下の精度で調整可能である。

通常、X線エネルギーが20 keV以下ではFZP、20 keV以上ではCRLsが利用される。典型的なビームサ イズとしてFZPでは8 keVにおいて0.24×0.31 µm²、 CRLsでは30 keVにおいて2.3×3.2 µm²程度の微小ビー ムが得られている。光量は各エネルギーでおよそ10⁹光 子数/秒程度である。本機構の整備により、集光X線の エネルギーを6~30 keVの広い範囲で迅速に切替可能に なった。これにより、逆格子マッピング測定と蛍光X線 マッピング測定を一件のユーザー課題中に実施するな ど、ビームタイムの柔軟な利用が可能になり、よりユー ザーが利用しやすい測定環境が整った。 JASRI 利用研究促進部門 回折・散乱Ⅱグループ

田尻 寛男、隅谷 和嗣、今井 康彦